固物 2014 期中 A 卷

Deschain

2022年4月27日

物	理	常	数
---	---	---	---

$k_B = 1.381 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$	$\hbar = 1.054 \times 10^{-34} J \cdot s$	$q = 1.602 \times 10^{-19} C$	$m = 9.109 \times 10^{-31} kg$
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$			

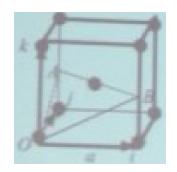
$N_A = 0.022 \times 10$
1. 填空题(每空 1 分,共 30 分)
(1) GaAs 的晶体结构是结构,其布拉菲格子是格子。
(2) 碱金属晶体是体心立方晶格,其倒格子为格子。若倒格子基矢为 $ec{eta}_1,ec{eta}_2,ec{eta}_3$,则碱金属
晶体晶面指数为 (231) 的晶面族的面间距可表示为。假设碱金属的晶格常数为 a ,
则其电子浓度为。
(3) 假设 Si 的晶格常数为 a ,则其布拉菲格子原胞的体积为,第一布里渊区的体积为。
(4) 晶体中的缺陷按其几何类型可以分为缺陷、线缺陷和 缺陷。其中线缺陷又分为位错
和 位错。
(5) 原子的结合中,吸引作用主要来自于异性电荷之间的作用,而排斥作用来自于同性电荷之间
的作用以及原理引起的排斥。一般固体的结合可以概括为四种基本形式,除了离
子性结合之外,还包括结合、结合和
结合的方式是典型的结合,其电离度为。
(6) 假设金属晶体的总体积为 V ,则 k 空间的点阵密度为。能量标度下电子的能态密度会随着能
量的增大而。
(7) 两块同种原子组成的金属晶体,体积分别为 V_1 和 V_2 ,且 $V_1>V_2$,则自由电子的数目 N_1 N $_2$,
费米能级 $E_{F1}_{2}_{2}$ (填 >, <, =)
(8) 布洛赫能带理论相比索末菲自由电子模型,主要是考虑了晶体中的对电子运动的影
响。
(原图缺失)

2. 简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

- (1) 请简述晶体、非晶体和准晶体之间的区别。
- (2) 请说明空穴的物理意义。
- (3) 请描述周期性边界(波恩-卡曼)条件并说明其在什么条件下适用。
- (4) 请用能带理论简述导体、绝缘体和半导体的区别。

3. (8 分) 如图所示,是一个体心立方晶格的单胞,其晶格常数为 a, A 和 B 都是各自边矢量的中点。

- (1) 写出 OAB 晶面的密勒指数。
- (2) 求 OAB 晶面的面间距。



- 4. (6 分) 相距为 r 的两原子,相互作用势能可以表示为 $u(r)=u_0[(\frac{\sigma}{r})^m-(\frac{\sigma}{r})^n]$,分别求出势能最小值和吸引力最强时的距离。(原题不是 m 和 n,但图片看不清)
- 5. (8 分) 假设一个晶格常数为 a 的一维晶格中,电子能量 $E(k)=E_0-2E_1cos(ka)$,其中 $E_1>0$
- (1) 分别求能带底和能带顶处的简约波矢和能量。
- (2) 分别求能带底和能带顶处电子的有效质量。
- 6. (8 分) 电子在一个晶格常数为 a 的一维晶体中运动。
- (1) 求布里渊区边界 $\frac{2\pi}{a}$ 处自由电子的能量。
- (2) 假设单个电子感受到的周期性势场 $V(x) = -V_0 cos(\frac{4\pi x}{a}) cos(\frac{2\pi x}{a})$, 其中 $V_0 > 0$ 。采用近自由电子近似分别求出布里渊区边界 $\frac{\pi}{a}, \frac{2\pi}{a}, \frac{3\pi}{a}$ 处的能隙。
- 7. (20 分) 已知一种由同种原子组成的金属晶体。(原图缺失)

1. 填空题答案

(1) ①闪锌矿 ②面心立方

(2) ①面心立方 ②
$$\frac{2\pi}{\|\vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2 + \vec{\beta}_3\|}$$
 ③ $\frac{2}{a^3}$

 $2\frac{32\pi^3}{a^3}$ (3) $\oplus \frac{a^3}{4}$

(4) ①点 2面 ③刃形 ④螺形

(5) ①吸引 ②排斥 ③泡利不相容 ④共价⑤金属性 ⑥范德瓦耳斯力 ⑦共价

80

(6) $\mathbb{O}^{\frac{V}{8\pi^3}}$ ②增大

(8) ①周期性势场

2. 简答题答案

(1) ①晶体:内部原子的排列具有空间周期性。

②非晶体:内部原子的排列不具有周期性。

③准晶体:内部原子的排列具有旋转对称性,没有平移对称性(或具有长程取向序,无长程平移序)。

(2) 空穴是满带缺少电子的状态,实际上描述的是满带中其他电子的运动。

(3) $\mathfrak{D}\psi(x) = \psi(x + Na)$

②是忽略边界影响时的边界条件。

(4) ①导体: 价带完全填充,导带部分填充,导电性良好。

②绝缘体: 价带完全填充, 导带是空带, 并且带隙较大, 不易发生跃迁, 因此几乎不导电。

③半导体:绝对零度时,价带完全填充,导带是空带,但是带隙较小。室温下,一部分电子可以从价带上 被热激发到导带上。导带和价带都变成部分填充,可以导电。

3. 解答

 $(1) (11\overline{2})$

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

4. 解答

设势能最小的位置为 r_1 , 吸引力最强的位置为 r_2 , 则

$$\begin{split} \frac{dU}{dr} &= u_0(-\frac{m\sigma^m}{r^{m+1}} + \frac{n\sigma^n}{r^{n+1}}) = 0, \quad r_1 = (\frac{n}{m})^{\frac{1}{n-m}}\sigma \\ \frac{d^2U}{dr^2} &= u_0(\frac{m(m+1)\sigma^m}{r^{m+2}} - \frac{n(n+1)\sigma^n}{r^{n+2}}) = 0, \quad r_2 = (\frac{n(n+1)}{m(m+1)})^{\frac{1}{n-m}}\sigma \end{split}$$

5. 解答

(1) 能帯底 k = 0, 能量 $E(0) = E_0 - 2E_1$

能带顶
$$k = \frac{\pi}{a}$$
,能量 $E(\frac{\pi}{a}) = E_0 + 2E_1$
(2) $m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}} = \frac{\hbar^2}{2a^2 E_1 cos(ka)}$

能带底 $m^* = \frac{\hbar^2}{2a^2E_1}$,能带顶 $m^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2E_1}$

6. 解答

(1)

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

(2)
$$V(x) = -\frac{V_0}{4} \left(e^{i\frac{6\pi}{a}x} + e^{i\frac{2\pi}{a}x} + e^{-i\frac{2\pi}{a}x} + e^{-i\frac{6\pi}{a}x} \right)$$

$$V_{\pm 1} = -\frac{V_0}{4}, \quad V_{\pm 3} = -\frac{V_0}{4}$$

 $\frac{\pi}{a}$ 处能隙为 $\frac{V_0}{2}$, $\frac{2\pi}{a}$ 处能隙为 $0,\frac{3\pi}{a}$ 处能隙为 $\frac{V_0}{2}$ 。